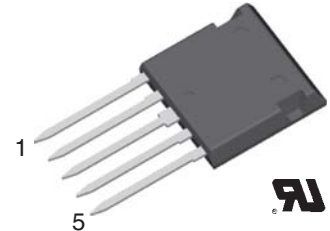
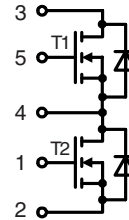


HiPerFET™ Power MOSFET

Phaseleg Topology
in ISOPLUS i4-PAC™

$$\begin{aligned} I_{D25} &= 75 \text{ A} \\ V_{DSS} &= 100 \text{ V} \\ R_{DSon typ.} &= 18 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

Preliminary data



MOSFET T1/T2				
Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
V _{DSS}	T _{VJ} = 25°C to 150°C	100	V	
V _{GS}		±20	V	
I _{D25}	T _C = 25°C	75	A	
I _{D90}	T _C = 90°C	50	A	
I _{F25}	(body diode) T _C = 25°C	100	A	
I _{F90}	(body diode) T _C = 90°C	60	A	
dv/dt	V _{DS} < V _{DSS} ; I _F ≤ 300A; di _F /dt ≤ 100A/μs; R _G = 2 Ω T _{VJ} = 150°C	5	V/ns	
E _{AR}	T _C = 25°C	30	mJ	
Symbol	Conditions	Characteristic Values (T _{VJ} = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ. max.	
R _{DSon}	V _{GS} = 10 V; I _D = I _{D90}		18 25 mΩ	
V _{GSth}	V _{DS} = 20 V; I _D = 4 mA	2	4 V	
I _{DSS}	V _{DS} = V _{DSS} ; V _{GS} = 0 V; T _{VJ} = 25°C T _{VJ} = 125°C		0.25 0.3 mA	
I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V; V _{DS} = 0 V		200 nA	
Q _g Q _{gs} Q _{gd}	V _{GS} = 10 V; V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} ; I _D = I _{D90}		180 35 85	
t _{d(on)} t _r t _{d(off)} t _f		V _{GS} = 10 V; V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} I _D = I _{D90} ; R _G = 2 Ω	20 60 80 60	ns ns ns ns
V _F			(body diode) I _F = 75 A; V _{GS} = 0 V	1.2
t _{rr}	(body diode) I _F = 37.5A; -di/dt = 100A/μs; V _{DS} = 25V		300	ns
R _{thJC} R _{thJH}	with heat transfer paste		0.93	0.5 K/W K/W

Features

- HiPerFET™ technology
 - low R_{DSon}
 - low gate charge for high frequency operation
 - unclamped inductive switching (UIS) capability
 - dv/dt ruggedness
 - fast intrinsic reverse diode
- ISOPLUS i4-PAC™ package
 - isolated back surface
 - low coupling capacity between pins and heatsink
 - enlarged creepage towards heatsink
 - application friendly pinout
 - low inductive current path
 - high reliability
 - industry standard outline
 - UL registered E 72873

Applications

- drives and power supplies
- battery or fuel cell powered
- automotive, industrial vehicle etc.
- secondary side of mains power supplies

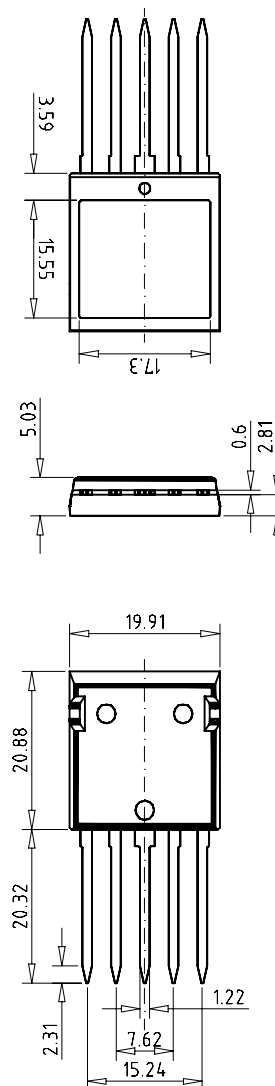
IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© 2004 IXYS All rights reserved

Component

Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
T_{VJ}		-55...+150	°C
T_{stg}		-55...+125	°C
V_{ISOL}	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}; 50/60 \text{ Hz}$	2500	V~
F_c	mounting force with clip	20...120	N

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		min.	typ.	max.
C_p	coupling capacity between shorted pins and mounting tab in the case		40	pF
d_s, d_A	pin - pin	1.7		mm
d_s, d_A	pin - backside metal	5.5		mm
Weight			9	g

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")


Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9